

# 定制 Ptfе 半导体晶圆清洗花篮 耐腐蚀 低本底 实验室支架

货号: PL-CP267



## 简介

使用我们的定制 PTFE 清洗花篮，在半导体制造中实现卓越的纯度。该产品专为极致的耐化学性和低本底干扰而设计，这些坚固的支架可确保高效的晶圆处理、快速排液，并在关键的高纯度实验室环境中提供可靠的性能。

## [了解更多](#)

应用	描述	主要优势
RCA 清洗工艺	用于 SC-1 和 SC-2 序列，以去除硅晶圆上的有机残留物和金属污染物。	由于超纯、低析出材料表面，防止了再污染。
食人鱼蚀刻	在硫酸和过氧化氢混合液中处理晶圆，以去除光刻胶。	对侵蚀性氧化环境具有出色的耐受性，且无结构降解。
氢氟酸浸泡	使用浓 HF 或缓冲 HF 溶液去除硅基底上的原生氧化层。	完全免疫 HF 攻击，确保设备的长期生存能力和工艺纯度。
CMP 后清洗	在化学机械抛光后清洗晶圆，以去除浆料颗粒和化学品。	快速排液和不粘特性防止浆料颗粒粘附在花篮上。
光刻显影	在光刻胶层的显影和剥离过程中支撑基底。	高尺寸稳定性确保在关键光刻步骤中的精确对准和处理。
痕量分析准备	清洗 ICP-MS 和其他高灵敏度分析技术中使用的实验室器皿和容器。	极低的本底水平确保检测痕量金属杂质具有最高的准确性。
GaAs 晶圆处理	通过专门的蚀刻和漂洗循环处理化合物半导体晶圆。	温和的支撑结构防止易碎化合物半导体材料的破损。
超声波清洗	在高频声学清洗循环中作为浸没式载具使用。	高效传输超声波能量，同时保护晶圆不与槽体发生机械接触。

特性	PL-CP267 规格详情
型号标识符	PL-CP267
主要材料	高纯度原生 PTFE (聚四氟乙烯)
制造工艺	100% 精密 CNC 加工 (无注塑残留物)
耐化学性	完全耐受 HF、H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 、HNO <sub>3</sub> 、HCl、KOH 和有机溶剂
温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
表面光洁度	光滑、低孔隙率表面，以最大限度地减少颗粒截留
配置选项	完全可定制 (晶圆尺寸、槽宽、槽距、手柄设计)
晶圆兼容性	适用于 2"、3"、4"、6"、8" 和 12" 晶圆或定制尺寸
排液设计	提供 V 型底或 U 型底槽型轮廓，以优化流体排放
本底水平	经过专门处理，以满足亚 ppb 级金属杂质要求